## Структура и свойства интеркалатного соединения $Cu_x TiSe_2$

© А.А. Титов, А.И. Меренцов, А.Е. Карькин\*, А.Н. Титов\*, В.В. Федоренко\*

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург, Россия \* Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

E-mail: a.a.titov@mail.ru

(Поступила в Редакцию 22 апреля 2008 г.)

Методом прямого синтеза из элементов синтезирована квазибинарная интеркалатная система Cu-TiSe<sub>2</sub>. Изучена ее фазовая диаграмма, определена граница растворимости меди и структура материала. В диапазоне концентраций меди вплоть до 60 mol% выращены монокристаллы и измерена температуная зависимость сопротивления. Показано, что в изученном концентрационном интервале интеркалация меди приводит к комплексу явлений, наблюдающихся при интеркалации щелочных металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 06-03-32900 и программы Минобрнауки РФ "Развитие научного потенциала высшей школы" (РНП.2.1.1.6945).

PACS: 81.05.Bx, 81.10.Aj, 72.15.-v

Надавно обнаруженный факт сосуществования в системе  $Cu_x TiSe_2$  состояния с волной зарядовой плотности и сверхпроводимости вызвал большой интерес к этому материалу. Вслед за пионерской работой [1] во всех последующих (см., например, [2,3]) отмечалась ограниченность растворимости меди в системе  $Cu_x TiSe_2$  предельным составом  $Cu_{0.11}TiSe_2$ . Столь низкое значение предельной растворимости не имеет аналогов среди интеркалатных соединений дихалькогенидов титана и должно, вероятно, иметь вескую физическую причину. Для проверки этого результата мы предприняли синтез и структурный анализ соединений системы  $Cu-TiSe_2$ .

В отличие от использованного во всех остальных работах метода газотранспортных реакций мы использовали в качестве основного обычный ампульный синтез с керамическими образцами, полученными диффузионным твердофазным внедрением металлической меди в заранее синтезированный TiSe2. Для внедрения мы использовали медь марки ОСЧ 11-4 чистотой 99.99%. Реакция внедрения проводилась при температурах 450 и 950°С в откачанных до  $10^{-5}$  torr кварцевых ампулах. Гранулы меди, использованные при синезе, имели характерный размер  $\sim 5 \times 2 \times 2$  mm. По-видимому, столь крупный размер не позволял получить однородный материал в один прием, несмотря на очевидно высокую диффузионную подвижность меди. В связи с этим образцы подвергались гомогенизации путем размола, перемешивания, прессования и последующего отжига при той же температуре. Для образцов, синтезированных при температуре 950°С, этой процедуры оказалось достаточно для получения визуально однородного материала. Материал же, синтезировавшийся при темературе 450°С, оказался неоднородным и загрязненным Cu<sub>2</sub>Se. Многократное повторение гомогенизации снижало содержание этой фазы, но полностью избавиться от нее не удавалось, по крайней мере до трех циклов. Такой эффект никогда не наблюдался в материалах, интеркалированных металлами с диффузионной подвжиностью, далекой от суперионных величин. Вероятно, это связано с протеканием конкурирующих процессов взаимодействия меди с TiSe<sub>2</sub> и парами селена над его поверхностью. Поскольку давление насыщенного пара селена над TiSe<sub>2</sub> достаточно велико, высокий коэффициент диффузии меди как в TiSe<sub>2</sub>, так и в Cu<sub>2</sub>Se приводит к образованию значительного количества посторонней фазы.

Аттестация полученных визуально гомогенных образцов выполнялась методом рентгеноструктурного анализа (аппарат ДРОН-6, Со  $K_{\alpha}$ -излучение, Fe-фильтр). Следует отметить, что несмотря на видимую гомогенность, на рентгенограммах образцов все же присутствуют слабые линии Cu<sub>2</sub>Se. Содержание этой фазы, оцененное по соотношению интенсивностей наиболее сильных линий (111) Cu<sub>2</sub>Se и (101) фазы Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>, изоструктурной TiSe<sub>2</sub>, показано на рис. 1. Таким образом, реальное содержание меди x в Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub> меньше номинального примерно на величину, соответствующую данным рис. 1, поскольку часть меди пошла на образование Cu<sub>2</sub>Se.



**Рис. 1.** Отношение интенсивностей линий (111) Cu<sub>2</sub>Se и (101) Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub> как функция содержания меди в навеске.



**Рис. 2.** Постоянные решетки  $Cu_x TiSe_2$  в зависимости от содержания меди *x*.

Основной фазой всех исследованных образцов являлась фаза, изоструктурная TiSe<sub>2</sub>, параметры решетки которой зависели от содержания меди в образце. Это позволяет идентифицировать ее как Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>. Зависимость постоянных решетки Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub> от содержания меди x, задаваемого при навеске, приведена на рис. 2. Хорошо видно, что при x > 0.8 параметры становятся постоянными, что, очевидно, указывает на предел растворимости меди. С этим выводом хорошо согласуется резкое возрастание содержания Cu<sub>2</sub>Se в этой области (рис. 1). Ясно, что эта фаза образуется из нерастворившейся меди, захватывающей Se из пара над поверхностью Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>.

Поскольку ошибка, связанная с образованием Cu<sub>2</sub>Se в области x < 0.8, намного меньше величины изменения концентрации меди, задаваемой при синтезе (рис. 1), растворимость меди в TiSe2 намного превосходит объявленную в [11] величину x = 0.11. Представляется, что такое различие связано с разной методикой получения образцов. В работе [1] интеркалация меди в TiSe<sub>2</sub> осуществлялась методом газотранспортных реакций одновременно с выращиванием кристаллов. При этом в качестве источника меди и газа-носителя — Cl использовался CuCl. Очевидно, что увеличение содержания меди требует увеличения концентрации CuCl в рабочем объеме реактора. Но это приводит и к росту давления Cl, а следовательно, к сдвину равновесия реакции  $CuCl + TiSe_2 = Cu_x TiSe_2 + Cl$  влево. Таким образом, предел растворимости x = 0.11, полученный при таком методе синтеза, следует рассматривать не как равновесие между металлической медью и Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>, но как равновесие между CuCl и Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>. Полученный же нами предел растворимости соответствует равновесию Cu<sub>r</sub>TiSe<sub>2</sub> с металлической медью.

Во всем исследованном интервале растворимости меди в TiSe<sub>2</sub> вплоть до предела растворимости при x = 0.8на порошковых рентгенограммах не наблюдается никаких линий, которые можно было бы связать с упорядочением меди в решетке Cu<sub>x</sub> TiSe<sub>2</sub>. Концентрационная зависимость параметров решетки Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub> демонстрирует увеличение параметра  $c_0$  в области x < 0.6. Такое поведение характерно для щелочных металлов, которые не образуют ковалентных связей с решеткой-матрицей. В этом случае интеркалация сопровождается переносом валентного электрона в зону проводимости TiSe2, как правило, без существенного искажения плотности состояний в ней. Очевидно, что это должно приводить к росту концентрации свободных носителей заряда и, следовательно, проводимости металлического типа. Для проверки этого утверждения мы выполнили измерение температурных зависимостей проводимости и постоянной Холла на монокристаллических образцах Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub>. Измерения были выполнены на монокристаллических образцах вдоль базисной плоскости кристаллов.

Для выращивания кристаллов мы использовали метод газотранспортных реакций в двух основных вариантах. Прежде всего монокристаллы Cu<sub>x</sub>TiSe<sub>2</sub> выращивались с использованием брома в качестве газа-носителя. Для этого в ампулу с TiSe2 добавляли CuBr и требуемое количество металлической меди. Процесс протекает достаточно интенсивно даже при столь низких температурах, как 400°С, и позволяет получить кристаллы с размерами до  $5 \times 5 \times 0.01$  mm. При больших концентрациях меди ( $x \sim 0.3$  и больше) процесс выращивания сильно замедляется. Вероятно, это связано с тем обстоятельством, что большое содержание металлической меди снижает давление газа-носителя вследствие его связывания. Это вынудило нас использовать традиционный метод выращивания с йодом в качестве газа-носителя для кристаллов с большим содержанием меди. Этот метод применим при температурах не ниже 600°C и также позволяет получать качественные и достаточно крупные кристаллы. Состав кристаллов, как правило, слегка отличался от состава шихты и аттестовывался с помощью микрозондового анализа с использованием микроскопа JEOL-733. Анализ показал, что содержание газа-носителя в итоговых кристаллах не превосходит 0.1 at% для низкотемпературного метода и находится за пределами чувствительности в случае выращивания с использованием йода при температурах выше 600°С. Следует отметить, что при низкотемпературном выращивании перенос наблюдался на горячий конец, тогда как в высокотемпературном варианте перенос происходил на холодный конец. Это обстоятельство наряду с различной степенью загрязненности кристаллов, полученных этими методами, наводит на мысль о возможных различиях в механизмах роста. Обоими методами нам удалось вырастить кристаллы в диапазоне концентраций меди 0 < x < 0.58, т.е. в области, практически совпадающей с областью увеличения параметра  $c_0$  с ростом x.

Измерения проводимости выполнены четырехзондовым методом в геометрии Монтгомери [5]. Результаты измерений приведены на рис. 3 и 4. Хорошо видно, что проводимость носит металлический характер и увеличивается с ростом содержания меди. Эти данные хорошо согласуются с выводом о донорном характере меди в  $Cu_x TiSe_2$  в диапазоне  $x \simeq 0-0.6$ . Донорный характер подтверждает также отрицательная величина постоянной Холла (рис. 5). Прямым доказательством переноса заряда от меди на решетку  $TiSe_2$  является зависимость концентрации носителей заряда, полученная из постоянной Холла, от содержания меди, приведенная на рис. 6.

В области концентрации меди от 0.6 до 0.8 наблюдается необычное поведение параметров решетки, указывающих на ее сжатие в направлении нормали к базисной плоскости с увеличением содержания меди. Это характерно для материалов, в которых интеркалация приводит к формированию ковалентных центров, захватывающих электроны проводимости. Такая ситуация может возникнуть [6] в случае, если гибридные состояния Cu4S/Ti3d, центров Ti-Cu-Ti, которые могут действовать как ловушки свободных электронов и центры деформации решетки, расположены немного выше уровня Ферми в TiSe<sub>2</sub>. Тогда они начинают заполняться по достижении уровнем Ферми дна зоны примесных



**Рис. 3.** Температурные зависимости проводимости монокристаллов Cu<sub>x</sub> TiSe<sub>2</sub>.



**Рис. 4.** Концентрационная зависимость проводимости монокристаллов Cu<sub>x</sub> TiSe<sub>2</sub> при температуре 1.6 K.



**Рис. 5.** Концентрационная зависимость постоянной Холла монокристаллов Cu<sub>x</sub> TiSe<sub>2</sub> при температуре 1.6 К.



**Рис. 6.** Зависимость концентрации носителей, рассчитанной из постоянной Холла при температуре 1.6 K, от содержания меди в монокристаллах Cu<sub>x</sub> TiSe<sub>2</sub>.

состояний. Уровень же Ферми возрастает вследствие переноса электронов меди в зону проводимости TiSe<sub>2</sub>, как это показывают прямые измерения методом ARPES (фотоэмиссионная спектроскопия с угловым разрешением) [7]. Проверить это можно было бы прямыми измерениями сопротивления, однако пока нам не удалось вырастить монокристаллы требуемого состава (x = 0.6-0.8). Следует заметить, что на концентрационной зависимости как проводимости, так и конциентрации носителей заряда вблизи состава x = 0.6 наблюдается тенденция к насыщению или даже снижению. Это подтверждает наши предположения, хотя эффект слишком мал для уверенных утверждений.

Таким образом, можно считать установленным, что растворимость меди в  $TiSe_2$  составляет не менее 80 mol%, и в области концентраций x < 0.6 интеркалация меди приводит к переносу заряда в зону проводимости  $TiSe_2$ .

## Список литературы

- E. Morosan, H.W. Zandbergen, B.S. Dennis, J.W.G. Bos, Y. Onose, T. Klimczuk, A.P. Ramires, N.P. Ong, R.J. Cava. Nature Physics 2, 544 (2006).
- [2] G. Wu, H.X. Yang, L. Zhao, X.G. Luo, T. Wu, G.Y. Wang, X.H. Chen. Phys. Rev. B. 76, 024 513 (2007).
- [3] G. Li, W.Z. Hu, J. Dong, D. Qian, D. Hsieh, M.Z. Hasan, E. Morosan, R.J. Cava, N.L. Wang. Phys. Rev. Lett. 99, 167 002 (2007).
- [4] А.Н. Титов, А.В. Долгошеин, И.К. Бдикин, С.Г. Титова. ФТТ 42, 1567 (2000).
- [5] H.C. Montgomery. J. Appl. Phys. 42, 2971 (1971).
- [6] А.Н. Титов, Х.М. Биккин. ФТТ 34, 3593 (1992).
- [7] D. Qian, D. Hsieh, L. Wray, E. Morosan, N.L. Wang, Y. Xia, R.J. Cava, M.Z. Hasan. Phys. Rev. Lett. 98, 117 007 (2007).